

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HG SEMICONDUCTOR LIMITED

宏光半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6908)

須予披露交易之 補充公佈

茲提述宏光半導體有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)於二零二三年九月二十八日刊發之有關(其中包括)增資之公佈(「該公佈」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙應與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供以下有關增資協議的其他資料。

總認購價的釐定基準

本公司擬進一步闡明總認購價的釐定基準：

- (i) **GaN及項目公司半導體產品的樂觀商業前景；**
- (ii) **目標集團處於發展階段，因此其主要業務尚未產生重大收入，且一直錄得虧損；**

誠如本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度報告所述，中國政府已採納有利政策及措施促進半導體產業的發展。多項「十四五」規劃相關政策均將集成電路列入重點發展項目，而中國科學技術部亦將「新型顯示與戰略性電子材料」列為二零二三年重點專項，表明國家大力發展半導體行業的決心。此外，誠如本公司截至二零二三年六月三十日止六個月的中期報告所述，根據美國半導體行業協會最新預測，預計全球半導體銷售額於二零二四年將增長至5,760億美元，為行業歷史上的最高銷售總額。

半導體市場對高頻的需求不斷增長，以及新能源汽車、快速充電和光伏逆變器等板塊的興起促進了Ga_N半導體市場的蓬勃發展。市場上殷切的需求為本集團的第三代半導體Ga_N產業鏈業務奠定了堅實的發展基礎。鑑於全球Ga_N功率器件市場的增長，本公司認為Ga_N在中國第三代半導體產業中擁有廣闊的發展前景。隨著新能源行業的快速崛起，Ga_N被應用於電動汽車、無線充電、5G基礎設施等領域，為其未來發展釋放出巨大潛力。

儘管項目公司處於發展階段，因此其半導體業務尚未產生重大收入，且一直錄得虧損，但其在Ga_N領域強大的研發能力及產品開發技術使項目公司得以從仍處於發展初期階段的中國市場的巨大潛力中受益。此外，目標集團持續升級其核心設備，全速推進第三代半導體Ga_N業務發展。隨著二零二二年及二零二三年取得越來越多的實用新型及外觀專利，本集團相信目標集團未來將逐步邁入收穫期，以及透過引入擁有豐富資源及廣泛投資經驗的戰略投資人，為目標集團之業務發展注入動力，以鞏固其財務狀況，符合本集團的利益。

增資表明投資人及本集團對Ga_N未來業務前景及項目公司半導體產品充滿信心。

- (iii) 項目公司於二零二三年六月三十日的未經審核資產淨值為人民幣**99.28**百萬元；
- (iv) 根據總認購價除以目標公司經增資擴大後註冊資本的**9.0909%**計算，目標集團的隱含內在估值為人民幣**1,100**百萬元；及
- (v) 基於內在估值及項目公司於二零二三年六月三十日未經審核的資產淨值之市價淨資產比率。

鑑於當前市場情況困難，增資為本集團提供寶貴的機會以為項目公司的業務發展籌集資金，而其表明投資人對目標集團的未來前景充滿信心。總認購價乃由投資人與目標公司經考慮上述第三代半導體Ga_N業務的樂觀商業前景後公平磋商釐定；及完成後，投資人將持有目標公司註冊資本的**9.0909%**，隱含內在估值為人民幣**1,100**百萬元。內在估值較項目公司於二零二三年六月三十日的資產淨值約人民幣**99.28**百萬元大幅溢價約人民幣**1,000.72**百萬元，其代表市價淨資產比率（「市淨率」）約為**11**倍，遠高於在中國主要從事半導體產品設

計、開發、製造、分包服務及銷售的同類公司的市淨率(以其在聯交所上市股份於增資協議日期的收市價計算)。

先決條件

與關鍵員工訂立的勞動協議

作為一項先決條件，目標公司或項目公司須與目標公司或項目公司的關鍵員工訂立勞動協議、保密協議、知識產權所有權協議及競業禁止協議，以確保其受該等投資人所協定條款的約束，旨在確保關鍵員工對目標公司或項目公司的長期承諾，並保障目標公司或項目公司的利益。

股東協議

認沽期權

誠如該公佈所披露，投資人有權(「認沽期權」)向回購義務人發出回購通知，要求回購義務人共同及個別購買回購股權，回購價為投資人向目標公司支付的總認購價的100%、按年利率8%單利計算的收益以及目標公司股東大會歷年來批准的已宣派但未實際支付給投資人的股息之和。

為說明用途，估計最高回購價格約為人民幣155.3百萬元，按下列主要假設及基準計算：(i) 投資人將成為目標公司股東的預計最早日期(即二零二三年十一月十五日，自增資協議日期起計約七週)，並考慮到就增資向中國有關政府部門完成工商登記手續所需的時間；(ii) 投資人將於二零三零年六月三十日向回購義務人發出書面通知，悉數行使認沽期權；及(iii) 回購價格將於二零三零年九月三十日(即投資人發出回購通知後三個月期間的最後一天)支付予投資人。

由於認沽期權的行使並非由本公司酌情決定，故根據上市規則，認沽期權將按其已獲行使歸類。鑑於根據上文所披露的估計最高回購價格，授出認沽期權的最高適用百分比高於5%但低於25%，因此授出認沽期權構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章的申報及公佈規定。

釋義

根據股東協議的釋義，該公佈所述「合資格上市」指目標公司(或相關重組後包括目標公司業務及資產在內的實體)在上海證券交易所、深圳證券交易所(不包括通過全國中小企業股份轉讓系統(亦稱為新三板)上市)或境外證券交易所(惟須事先獲得投資人的書面同意及目標公司股東的批准)首次公開發售及上市。

除上文所披露者外，該公佈所載的所有其他資料均維持不變，且就所有目的而言持續有效。本公佈是對該公佈的補充，應與該公佈一併閱讀。

承董事會命
宏光半導體有限公司
主席兼執行董事
徐志宏博士

香港，二零二三年十月十三日

於本公佈日期，執行董事為徐志宏博士、趙奕文先生、呂鎧麟先生(前名為呂向榮先生)、梁健鵬先生及陳振博士；非執行董事為王寧國博士；及獨立非執行董事為周偉誠教授、李陽先生、鄒海燕先生及蕭妙文先生，MH。

本公佈中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。